

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-211370

(P2013-211370A)

(43) 公開日 平成25年10月10日(2013.10.10)

(51) Int.Cl.

H01L 35/22 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)

F 1

H01L 35/22
H01L 35/34

テーマコード(参考)

(21) 出願番号
(22) 出願日

特願2012-79845(P2012-79845)

平成24年3月30日(2012.3.30)

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 15 頁)

(71) 出願人 592254526
 学校法人五島育英会
 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号

(74) 代理人 100081282
 弁理士 中尾 俊輔

(74) 代理人 100085084
 弁理士 伊藤 高英

(74) 代理人 100095326
 弁理士 畑中 芳実

(74) 代理人 100115314
 弁理士 大倉 奈緒子

(74) 代理人 100117190
 弁理士 玉利 房枝

(74) 代理人 100120385
 弁理士 鈴木 健之

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】MgAlB₁₄系のn-型熱電材料

(57) 【要約】

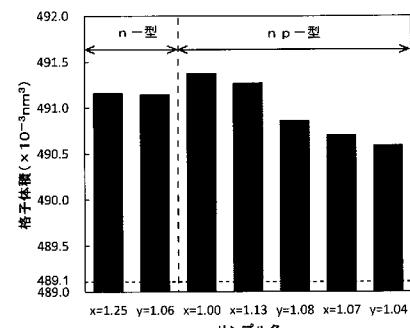
【課題】

本発明は、再現性よく安定して製造可能であり、生産性に優れたMgAlB₁₄系のn-型熱電材料を提供することを目的とする。

【解決手段】

Mg, AlおよびBを主成分とするMgAlB₁₄系のn-型熱電材料において、X線回折測定で求められるMgAlB₁₄の格子体積が489.1×10⁻³nm³より大きいMgAlB₁₄系のn-型熱電材料。

【選択図】 図5



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

Mg, Al および B を主成分とする MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料において、X線回折測定で求められる MgAlB_{1.4} の格子体積が $489.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ より大きいことを特徴とする MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【請求項 2】

50 から 800 の温度範囲において、常に n - 型の熱電特性を示すことを特徴とする請求項 1 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【請求項 3】

前記 MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料の MgAlB_{1.4} の格子体積が、 $491.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上であることを特徴とする請求項 2 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。 10

【請求項 4】

前記 MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料が、Mg, Al および B または Mg, Al, B および Si からなることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項に記載の MgA1B_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【請求項 5】

50 から 800 の温度範囲内における、所定の温度領域において、n - 型の熱電特性を示すことを特徴とする請求項 1 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【請求項 6】

前記 MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料の MgAlB_{1.4} の格子体積が、 $489.8 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上であることを特徴とする請求項 5 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。 20

【請求項 7】

前記 MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料が、Mg, Al および B, Mg, Al, B および C, Mg, Al, B および Cu, Mg, Al, B および Ni, Mg, Al, B および Si または Mg, Al, B および Te からなることを特徴とする請求項 5 または請求項 6 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【請求項 8】

酸化物相を含むことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。 30

【請求項 9】

前記酸化物相が、少なくとも MgAl₂O₄ からなることを特徴とする請求項 8 に記載の MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、多ホウ化物系の熱電材料のうち、MgAlB_{1.4} 系の n - 型熱電材料に関する。

【背景技術】

【0002】

熱電材料は、熱を電気に変換することができる材料であり、重金属を含み、常温から 600 程度以上の温度領域において熱電効果を示すもの、特許文献 1 に記載されているように、希土類元素を含み、600 程度の温度領域において n - 型の熱電特性を示すもの、ケイ化物や酸化物からなり 300 から 800 程度の温度領域において熱電効果を示すものが一般的な熱電材料として用いられている。特に、昨今、工場廃熱や自動車廃熱などの廃熱を有効利用することが検討されており、廃熱発電の国内市場規模の拡大も確実視されている。工場廃熱や自動車廃熱などは高温であるため、高温領域においても優れた熱電効果を示す熱電材料に注目が集まっている。 40

【0003】

高温領域においても優れた熱電効果を示す材料として、多ホウ化物系の熱電材料があげられる。多ホウ化物系の熱電材料は、温度上昇に伴って電気伝導率が増加し、ゼーベック係数については、変化しないあるいは増加するという熱電特性を示すことが報告されている。この報告に示されている特異な性質は、多ホウ化物を形成する正20面体クラスター固体が持つ性質が要因であると考えられている。

【0004】

また、実際に、熱電材料を熱電ユニットとする際には、n - 型とp - 型の熱電材料が直列に接続されて構成され、n - 型とp - 型の熱電材料の熱膨張率が極めて近似していることが好ましいとされている。一般的に、組成成分が同じ材料においては、近い熱膨張率の値を示しやすいことが知られており、同一の組成成分のn - 型とp - 型の熱電材料を用いることによって、熱膨張率の違いによる発電ユニットの破損を防ぎ、耐久性に優れた熱電ユニットを得ることができる。10

【0005】

本発明者等は、非特許文献1に記載のように、多ホウ化物系の熱電材料のうち、Mg、AlおよびBを主成分とするMgAl_{1.4}系の熱電材料についての研究を行い、電気伝導率が高く、優れた熱電特性を有するp - 型のMgAl_{1.4}系の熱電材料の作製に成功している。

【0006】

一方で、MgAl_{1.4}系のn - 型の熱電材料においては、Werheit等によって、単相のMgAl_{1.4}の試料において、n - 型の熱電特性を示すことが報告されている（非特許文献2を参照）。しかしながら、非特許文献3に記載の武田等の報告および非特許文献4に記載のGolikova等の報告において、MgAl_{1.4}の単相の試料がp - 型の熱電特性を示すという相反する報告がなされている。20

【0007】

なお、非特許文献5において、MgAl_{1.4}の単位格子はa = 5.848 × 10⁻¹ nm, b = 8.112 × 10⁻¹ nm, c = 10.312 × 10⁻¹ nmの斜方晶であることが報告されており、この報告に基づいて、MgAl_{1.4}の格子体積は、489.1 × 10⁻³ nm³であることが明らかとなっている。また、この時のMgAl_{1.4}の組成が化学量論比のMg_{0.78}Al_{0.75}B_{1.4}であることが開示されている。30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2007-53259号公報

【非特許文献】

【0009】

【非特許文献1】粉体および粉末冶金Vol. 58(2011), No. 2, pp. 105 - 109

【非特許文献2】Journal of Alloys and Compounds, 202(1993), pp. 269 - 281

【非特許文献3】JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 177(2004), pp. 471 - 47540

【非特許文献4】JJAP Series 10 PROCEEDING OF THE 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BORON, BORIDES AND RELATED COMPOUNDS TUKUBA(JAPAN) 1993, pp. 52 - 53

【非特許文献5】Journal of the Less Common Metals 92(2), pp. 239 - 246

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

まず、単相のMgAlB_{1.4}の熱電特性については、上記のように様々な研究者により検討がなされた結果、p - 型の熱電特性を有するという結論が推奨されており、非特許文献2の報告については、保証されていないのが現状である。

【0011】

さらに、非特許文献2の報告においては、MgAlB_{1.4}の単相の試料の具体的な作製方法の記載がなく、どのようにして当該試料が得られるのかについては明確とされていない。

【0012】

また、単相でのMgAlB_{1.4}系の熱電材料の実用化は、製造コストの面から現実的ではない。

10

【0013】

そこで、本発明においては、再現性よく安定的に製造可能であり、生産性に優れたMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明者等は、上記目的を達成するべく、鋭意研究を行い、化学量論組成のMgAlB_{1.4}の格子体積より大きな格子体積を有するMgAlB_{1.4}系の焼結体がn - 型熱電材料となると予測し、実験により検証して本発明を完成させた。格子体積を大きくする手法としては、MgAlB_{1.4}の化学量論組成よりMgおよびAlの組成比を増加させたり、MgAlB_{1.4}の結晶格子中に組み込まれる特性を有する他の異なる元素を添加することを採用した。

20

【0015】

本発明の第1のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、Mg, AlおよびBを主成分とするMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料において、X線回折測定で求められるMgAlB_{1.4}の格子体積が489.1×10⁻³nm³より大きいことを特徴とする。

【0016】

本発明の第2のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第1の態様において、50から800の温度範囲において、常にn - 型の熱電特性を示すことを特徴とする。

【0017】

本発明の第3のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第2の態様において、前記MgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料のMgAlB_{1.4}の格子体積が、491.1×10⁻³nm³以上であることを特徴とする。

30

【0018】

本発明の第4のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第1または第2のいずれか1つの態様において、前記MgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料が、Mg, AlおよびBまたはMg, Al, BおよびSiからなることを特徴とする。

【0019】

本発明の第5のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第1の態様において、50から800の温度範囲内における、所定の温度領域において、n - 型の熱電特性を示すことを特徴とする。

40

【0020】

本発明の第6のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第5の態様において、前記MgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料のMgAlB_{1.4}の格子体積が、489.8×10⁻³nm³以上であることを特徴とする。

【0021】

本発明の第7のMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料は、第5または第6の態様において、前記MgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料が、Mg, AlおよびB, Mg, Al, BおよびC, Mg, Al, BおよびCu, Mg, Al, BおよびNi, Mg, Al, BおよびSiまたはMg, Al, BおよびTeからなることを特徴とする。

【0022】

50

本発明の第8のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料は、第1乃至第7のいずれか1つの態様において、酸化物相を含むことを特徴とする。

【0023】

本発明の第9のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料は、第8の態様において、前記酸化物相が、少なくともMgAl₂O₄からなることを特徴とする。

【発明の効果】

【0024】

このような、本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料によれば、再現性よく安定して製造可能であり、生産性に優れた熱電材料を提供することを可能とする。

【0025】

さらに詳しくは、50から800という温度範囲において、優れたn-型の熱電特性を示すMgAlB₁₄系n-型熱電材料を提供することを可能とする。

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例1のX線回折パターンを示したグラフ

【図2】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例1の反射電子組成像

【図3】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例1のゼーベック係数の測定結果を示すグラフ

【図4】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例1の電気伝導率の測定結果を示すグラフ

【図5】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例1のMgAlB₁₄の格子体積の算出結果を示すグラフ

【図6】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例2のX線回折パターンを示したグラフであり、(a)は、Cを添加元素とした場合の測定結果を示し、(b)は、Cuを添加元素とした場合の測定結果を示し、(c)は、Niを添加元素とした場合の測定結果を示し、(d)は、Siを添加元素とした場合の測定結果を示し、(e)は、Teを添加元素とした場合の測定結果を示す。

【図7】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例2の組成画像であり、Siを添加元素として0.2mass%添加したサンプルの反射電子組成像を示す。

【図8】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例2のゼーベック係数の測定結果を示すグラフであり、(a)は、Cを添加元素とした場合の測定結果を示し、(b)は、Cuを添加元素とした場合の測定結果を示し、(c)は、Niを添加元素とした場合の測定結果を示し、(d)は、Siを添加元素とした場合の測定結果を示し、(e)は、Teを添加元素とした場合の測定結果を示す。

【図9】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例2の電気伝導率の測定結果を示すグラフであり、(a)は、Cを添加元素とした場合の測定結果を示し、(b)は、Cuを添加元素とした場合の測定結果を示し、(c)は、Niを添加元素とした場合の測定結果を示し、(d)は、Siを添加元素とした場合の測定結果を示し、(e)は、Teを添加元素とした場合の測定結果を示す。

【図10】本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料の実施例2のMgAlB₁₄の格子体積の算出結果を示すグラフ

【発明を実施するための形態】

【0027】

本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料は、Mg、AlおよびBを主成分とし、原料粉を放電プラズマ焼結装置(SPS)により焼結した焼結体において、X線回折測定で求められるMgAlB₁₄の格子体積が、化学量論組成のMgAlB₁₄の格子体積である489.1×10⁻³nm³より大きくなるようにされている。

【0028】

また、本発明のMgAlB₁₄系のn-型熱電材料は、MgAlB₁₄の格子体積が4

10

20

30

40

50

$91.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上とされており、Mg, Al および B または Mg, Al, B および Si の元素から構成される場合において、50 から 800 の温度範囲において、常に n - 型の熱電特性を示すようにされている。

【0029】

さらに、本発明の MgAlB_{14} 系の n - 型熱電材料は、 MgAlB_{14} の格子体積が $489.8 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上とされており、Mg, Al および B, Mg, Al, B および C, Mg, Al, B および Cu, Mg, Al, B および Ni, Mg, Al, B および Si または Mg, Al, B および Te の元素から構成されている場合において、50 から 800 の温度範囲内における、所定の温度領域において n - 型の熱電特性を示すようにされている。

10

【0030】

本発明の MgAlB_{14} 系の n - 型熱電材料は、組織内に酸化物相を含み、当該酸化物相が、少なくとも MgAl_2O_4 からなるようにされている。

【0031】

以下に、本発明の MgAlB_{14} 系の n - 型熱電材料の具体的な実施例について図 1 乃至図 10 を用いて詳しく説明する。

【0032】

< 実施例 1 >

本発明の MgAlB_{14} 系の n - 型熱電材料の実施例 1 の作製方法について説明する。

20

【0033】

出発原料粉として、純度 99.9 mass %、粒径 180 μm の Mg (高純度化学研究所製)、純度 99.9 mass %、粒径 10 μm の Al (高純度化学研究所製) および 純度 95.6 mass %、粒径 0.8 μm の B - amorphous (H.C. Stark 製) を用い、一般式が、 $\text{Mg}_x\text{Al}_y\text{B}_{14}$ ($x = 1.00 \sim 1.25$) または $\text{Mg}_y\text{Al}_{y-0.01}\text{B}_{14}$ ($y = 1.04 \sim 1.06$) の範囲内となるように秤量した。秤量した粉末を、V型混合機を用いて 30 分間混合し、放電プラズマ焼結装置 (SPS-511S、SPS シンテックス株式会社) (以降、SPS と称する。) を用いて、アルゴン雰囲気中において、1400 、 30 MPa の条件下で 10 分間加圧焼結を行い焼結体のサンプルを作製した。

【0034】

作製したサンプルを X 線回折装置 (NEW D 8 ADVANCE、ブルカ - エイエックスエス株式会社) (以降、XRD と称する。) により相同定を行った。なお、測定においては、Cu K 線を X 線源として用い、測定角度 15 ~ 55° の範囲で行った。また、電子プローブマイクロアナライザ (JXA-8200、日本電子株式会社) によりサンプルの組織観察を行った。さらに、熱電性能評価装置 (ZEM-1、アルバック理工株式会社) を用いて、50 から 800 の温度範囲において熱電特性を測定し、サンプルのゼーベック係数および電気伝導率の評価を行った。

30

【0035】

サンプルから得られた回折パターンを図 1 に示す。すべてのサンプルにおいて MgAlB_{14} 、 MgAl_2O_4 および B_2O の回折パターンが確認された。

40

【0036】

MgAlB_{14} 、 MgAl_2O_4 および B_2O の回折パターンが認められた $y = 1.06$ の反射電子組成像を図 2 に示す。暗色部は、 MgAlB_{14} を含む多ホウ化物相を示し、明色部は、 MgAl_2O_4 などの酸化物相を示している。多ホウ化物相の組織内に微細な粒子状の酸化物相が分散している様子が確認できる。このような酸化物相は、原料粉末に含まれていた酸素や、サンプルの作製時において原料粉末が大気に露出したことによって付着した酸素などが原料粉末と反応して生成されたものであると考えられる。

【0037】

各サンプルのゼーベック係数の温度依存性を図 3 に示す。ここで、ゼーベック係数が正の値を示す場合を p - 型の熱電特性を示すといい、負の値を示す場合を n - 型の熱電特性

50

を示すという。

【0038】

$x = 1.00 \sim 1.13$ 、 $y = 1.04$ および 1.08 のサンプルについては、符号 A で示した $470 \sim 550$ の温度範囲においてゼーベック係数の符号が反転し、当該温度範囲よりも高い温度、すなわち $550 \sim 800$ の温度領域においては p - 型の熱電特性を示し、当該温度範囲よりも低い温度、すなわち $50 \sim 470$ の温度領域においては n - 型の熱電特性を示した（以降、このように特定の温度領域において n - 型の熱電特性を示す場合は、n p - 型の熱電特性と称する）。また、 $y = 1.06$ および $x = 1.25$ のサンプルについては、 $50 \sim 800$ の温度領域において常に負の値を示し、n - 型の熱電特性を示した。特に、 $y = 1.06$ については、 $50 \sim 800$ の温度領域において、ゼーベック係数が $-500 \sim -600 \mu\text{V}/\text{K}$ と高い値を示した。10

【0039】

各サンプルの電気伝導率の温度依存性を図 4 に示す。Mg、Al の割合が高いサンプルほど大きな電気伝導率を示すことがわかる。さらに、温度上昇に伴って電気伝導率が向上することが確認された。

【0040】

また、サンプルの X 線回折結果をポーリー法で分析し、得られたサンプルの各格子定数から算出した MgAlB_{1.4} の格子体積の結果を図 5 に示す。なお、MgAlB_{1.4} の結晶構造は、斜方晶として分析を行った。20

【0041】

図 5 に示すように、いずれのサンプルについても、化学量論組成の MgAlB_{1.4} の格子体積である $489.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ よりも大きな格子体積を有していた。

【0042】

詳しくは、n - 型の熱電特性を示した $y = 1.06$ および $x = 1.25$ のサンプルは、共に MgAlB_{1.4} の格子体積が $491.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上であり、極めて近似した格子体積を有していた。n p - 型の熱電特性を示したサンプルは、 $490.6 \sim 491.4 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ の格子体積を有していた。20

【0043】

このような、本発明の実施例 1 の結果から、化学量論組成の MgAlB_{1.4} の格子体積である $489.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ よりも大きい格子体積とすることにより、 $50 \sim 800$ の温度範囲において、再現性よく安定して MgAlB_{1.4} 系の n - 型の熱電材料の製造が可能であり、優れた n - 型の熱電特性を示す MgAlB_{1.4} 系の熱電材料を得られることがわかった。特に、n - 型の熱電特性を示したサンプルの格子体積は、n p - 型の熱電特性を示したサンプルの格子体積と比較して、平均的に大きな格子体積を有することがわかった。30

【0044】

また、 $y = 1.06$ および $x = 1.25$ のサンプルからわかるように、MgAlB_{1.4} 格子体積が $489.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ より大きく、特に、 $491.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上とされることにより、 $50^\circ \sim 800^\circ$ の温度範囲において、温度変化に関係なく常に n - 型の熱電特性を有する MgAlB_{1.4} 系の n - 型の熱電材料を得ることができる。40
 $y = 1.06$ および $x = 1.25$ の 2 つのサンプルについては、図 3 に示すように、ゼーベック係数の値にほとんど温度依存性がないことから、 800 以上の温度領域においても、優れた n - 型の熱電特性を示すと考えられる。

【0045】

さらに、 $x = 1.00$ 、 $X = 1.07$ 、 $x = 1.13$ 、 $y = 1.04$ および $y = 1.08$ とすることにより、MgAlB_{1.4} の格子体積が $489.1 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ より大きく、特に、 $490.6 \times 10^{-3} \text{ nm}^3$ 以上とされ、所定の温度領域、すなわち、 $50 \sim 470$ の温度範囲において、n - 型の熱電特性を得ることができる。

【0046】

また、本発明の実施例 1 の結果から、多ホウ化物相の組織内に酸化物相を含んだ状態に50

おいても優れたn-型の熱電特性を示していることがわかる。このような、本発明のMg-Al-B₁₄系のn-型の熱電材料の実施例1によれば、得られた熱電材料の組織内から酸化物相を除去する必要性が無く、生産性に優れたMg-Al-B₁₄系のn-型の熱電材料を得ることができる。

【0047】

<実施例2>

また、本発明のMg-Al-B₁₄系のn-型熱電材料の実施例2の作製方法について説明する。

【0048】

Mg-Al-B₁₄の出発原料粉として、純度99.9mass%、粒径180μmのMg(高純度化学研究所製)、純度99.9mass%、粒径10μmのAl(高純度化学研究所製)、純度95.6mass%、粒径0.8μmのB-amorphous(H.C.Starck製)を用いた。また、添加元素の原料粉として、純度99.9mass%、粒径14.2~20μmのC(TIMCAL Graphite & Carbon製)、純度99.7mass%、粒径325μm以下のCu(山石金属株式会社製)、純度99.8mass%、粒径3.0~7.0μmのNi(Vale Inco Ltd.製)、純度99.9mass%、粒径45μmのSi(株式会社高純度化学研究所製)および純度99.999mass%、粒径150μmのTe(株式会社高純度化学研究所製)を用いた。

【0049】

【表1】

| サンプル名 | 組成比[at%] | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Mg _{1.06} Al _{1.05} B ₁₄ | C | Cu | Ni | Si | Te |
| c0.1 | 99.9 | 0.1 | - | - | - | - |
| c0.5 | 99.5 | 0.5 | - | - | - | - |
| cu0.1 | 99.9 | - | 0.1 | - | - | - |
| cu0.5 | 99.5 | - | 0.5 | - | - | - |
| cu1.0 | 99.0 | - | 1.0 | - | - | - |
| ni0.1 | 99.9 | - | - | 0.1 | - | - |
| si0.1 | 99.9 | - | - | - | 0.1 | - |
| si0.2 | 99.8 | - | - | - | 0.2 | - |
| si0.3 | 99.7 | - | - | - | 0.3 | - |
| si0.5 | 99.5 | - | - | - | 0.5 | - |
| si1.0 | 99.0 | - | - | - | 1.0 | - |
| te0.1 | 99.9 | - | - | - | - | 0.1 |
| te0.5 | 99.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| te1.0 | 99.0 | - | - | - | - | 1.0 |

【0050】

Mg, Al, Bおよび添加元素の出発原料粉を表1の割合となるようにそれぞれ秤量する。秤量した粉末を、V型混合機を用いて30分間混合し、SPSを用いて、アルゴン雰囲気中において、1500、30MPaの条件下で25分間加圧焼結を行い焼結体のサンプルを作製した。

【0051】

作製したサンプルについてXRDにより相同定を行った。なお、測定においては、CuK α 線をX線源として用い、測定角度15~55°の範囲で行った。また、電子プローブ

10

20

30

40

50

マイクロアナライザによりサンプルの組織観察を行った。さらに、熱電性能評価装置を用いて、50 ~ 800 の温度範囲において熱電特性を測定し、サンプルのゼーベック係数および電気伝導率の評価を行った。

【0052】

サンプルから得られた回折パターンを図6に示す。なお、(a)は添加元素としてCを添加した場合の測定結果を示し、(b)は添加元素としてCuを添加した場合の測定結果を示し、(c)は、添加元素としてNiを添加した場合の測定結果を示し、(d)は添加元素としてSiを添加した場合の測定結果を示し、(e)は添加元素としてTeを添加した場合の測定結果を示す。

【0053】

すべてのサンプルからMgAl_{1.4}、MgAl₂O₄およびB₂Oの回折パターンが確認された。Cuを添加したサンプルについては、AlCuおよびAl₂Cuが確認された。Siを添加したサンプルについては、Siの回折パターンが確認された。Teを添加したサンプルについては、TeおよびMgTeが確認された。

【0054】

サンプルsi0.2の反射電子組成像を図7に示す。暗色部は、MgAl_{1.4}を含む多ホウ化物相を示し、明色部は、MgAl₂O₄およびB₂Oなどの酸化物相を示す。

【0055】

多ホウ化物相の組織内に微細な粒子状の酸化物相が分散している様子が確認できる。このような酸化物相は、実施例1の場合と同様に、原料粉末に含まれていた酸素や、サンプル作製時において原料粉末を大気に露出したことによって付着した酸素などが、原料粉末と反応して生成されたと考えられる。

【0056】

各サンプルのゼーベック係数の温度依存性を図8に示す。なお、(a)は、Cを添加元素とした場合の測定結果を示し、(b)は、Cuを添加元素とした場合の測定結果を示し、(c)は、Niを添加元素とした場合の測定結果を示し、(d)は、Siを添加元素とした場合の測定結果を示し、(e)は、Teを添加元素とした場合の測定結果を示す。

【0057】

いずれの種類の添加元素を添加した場合においても、所定の温度領域においてゼーベック係数の符号が反転して熱電特性の性質が変化するn-p型が確認された。Cを添加元素としたサンプルについては、480および570付近においてゼーベック係数の符号が反転した。Cuを添加元素としたサンプルについては、370 ~ 480の温度領域においてゼーベック係数の符号が反転した。Niを添加元素としたサンプルについては、440付近においてゼーベック係数の符号が反転した。Siを添加元素として1.0mas%添加したサンプルについては、500付近においてゼーベック係数の符号が反転した。Teを添加元素としたサンプルについては、350 ~ 650の温度領域においてゼーベック係数の符号が反転した。

【0058】

また、Siを添加元素とするサンプルsi0.1, si0.2, si0.3およびsi0.5については、50 ~ 800の温度領域において、ゼーベック係数の符号が常に負の値を示し、n型の熱電特性を示した。特に、サンプルsi0.2においては、50 ~ 800の温度領域においてゼーベック係数が-480 ~ -700 μV/Kと安定した値を示した。

【0059】

各サンプルの電気伝導率の温度依存性を図9に示す。すべてのサンプルにおいて、温度依存性が認められ、温度の上昇に伴う電気伝導率の上昇が確認された。

【0060】

また、サンプルのX線回折結果をポーリー法で分析し、得られたサンプルの各格子定数から算出したMgAl_{1.4}の格子体積の結果を図10に示す。なお、MgAl_{1.4}の結晶構造は、斜方晶として分析を行った。

10

20

30

40

50

【0061】

図10に示すように、すべてのサンプルにおいて、化学量論組成のMgAlB_{1.4}の格子体積である489.1×10⁻³nm³より大きい格子体積を有していることがわかる。

【0062】

詳しくは、n - 型の熱電特性を示したサンプル si0.3, si0.5, si0.2 および si0.1 は、491.4 ~ 491.9 × 10⁻³nm³ と比較的大きな格子体積を有していることがわかる。また、np - 型を示したサンプルについては、サンプル c0.5 が 489.8 × 10⁻³nm³ と最も小さい格子体積を有し、サンプル cu0.5 が 491.5 × 10⁻³nm³ と最も大きい格子体積を有していた。

10

【0063】

このような、本発明の実施例2の結果から、化学量論組成のMgAlB_{1.4}の格子体積である489.1×10⁻³nm³よりも大きい格子体積とすることにより、50 ~ 800 の所定の温度範囲において、再現性よく安定してMgAlB_{1.4}系のn - 型熱電材料の製造が可能であり、優れたn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得られることがわかった。特に、n - 型の熱電特性を示したサンプルの格子体積は、np - 型の熱電特性を示したサンプルの格子体積と比較して、平均的に大きな格子体積を有することがわかった。

【0064】

また、以下に、np - 型の熱電特性を示したサンプルについて、図8および図10に基づいて、添加元素の種類ごとに詳しく効果を述べる。

20

【0065】

添加元素としてCを添加することにより、489.1×10⁻³nm³より大きく、特に、489.8 × 10⁻³nm³以上のMgAlB_{1.4}の格子体積を有し、所定の温度領域、すなわち、50 ~ 570 の温度領域においてn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得ることができる。

【0066】

添加元素としてCuを添加することにより、489.1×10⁻³nm³より大きく、特に、491.3 × 10⁻³nm³以上のMgAlB_{1.4}の格子体積を有し、所定の温度領域、すなわち、50 ~ 480 の温度領域においてn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得ることができる。

30

【0067】

添加元素としてNiを添加することにより、489.1×10⁻³nm³より大きく、特に、490.7 × 10⁻³nm³のMgAlB_{1.4}の格子体積を有し、所定の温度領域、すなわち、50 ~ 450 の温度領域においてn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得ることができる。

【0068】

添加元素としてSiを添加することにより、489.1×10⁻³nm³より大きく、特に、490.2 × 10⁻³nm³のMgAlB_{1.4}の格子体積を有し、所定の温度領域、すなわち、50 ~ 500 の温度領域においてn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得ることができる。

40

【0069】

添加元素としてTeを添加することにより、489.1×10⁻³nm³より大きく、特に、490.0 × 10⁻³nm³以上のMgAlB_{1.4}の格子体積を有し、所定の温度領域、すなわち、50 ~ 650 の温度領域においてn - 型の熱電特性を示すMgAlB_{1.4}系の熱電材料を得ることができる。

【0070】

また、本発明の実施例2の結果から、多ホウ化物相の組織内に酸化物相を含んだ状態においても優れたn - 型の熱電特性を示していることがわかる。このような、本発明のMgAlB_{1.4}系のn - 型の熱電材料の実施例2によれば、得られた熱電材料の組織内から酸

50

化物相を除去する必要性が無く、生産性に優れたMgAl_{1-x}B_x系のn-型の熱電材料とすることができる。

【0071】

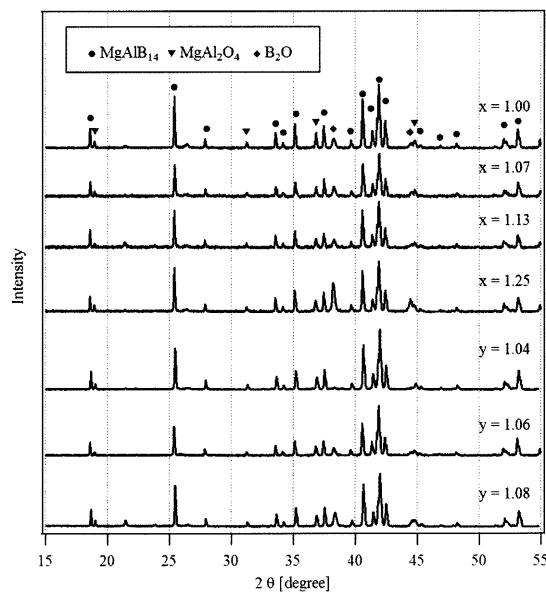
また、本実施例においては、1種類の添加元素を添加することにより、化学量論組成のMgAl_{1-x}B_xの格子体積よりも大きな格子体積とする方法を採用しているが、添加金属として2種類以上の元素を選択し、MgAl_{1-x}B_x系の熱電材料を作製した場合においても同様にn-型の熱電特性を有するMgAl_{1-x}B_x系のn-型熱電材料を提供することができる。

【0072】

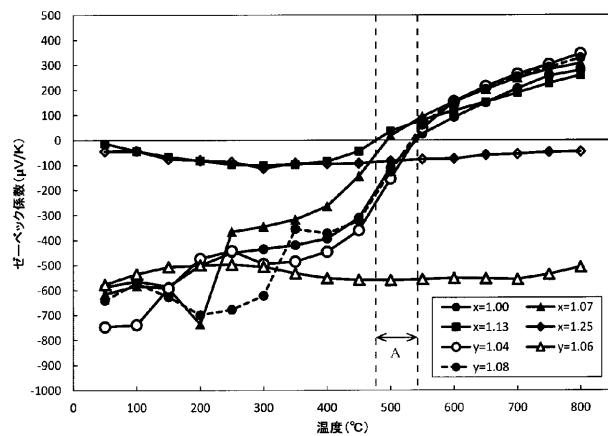
本発明のMgAl_{1-x}B_x系のn-型熱電材料は、実施例1および実施例2に限定されるものではなく、発明の特徴を損なわない範囲において種々の変更が可能である。

10

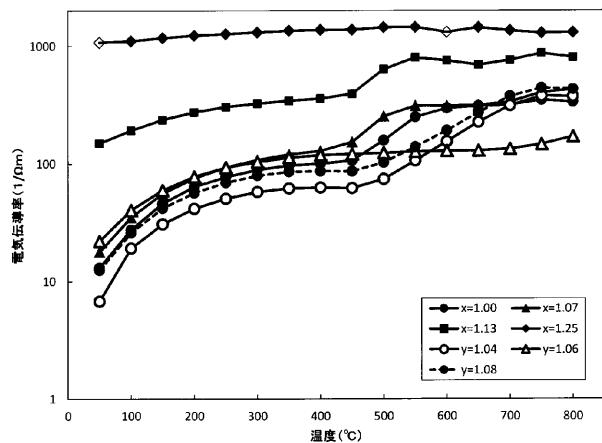
【図1】



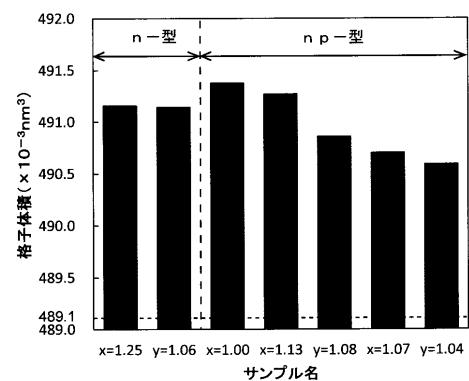
【図3】



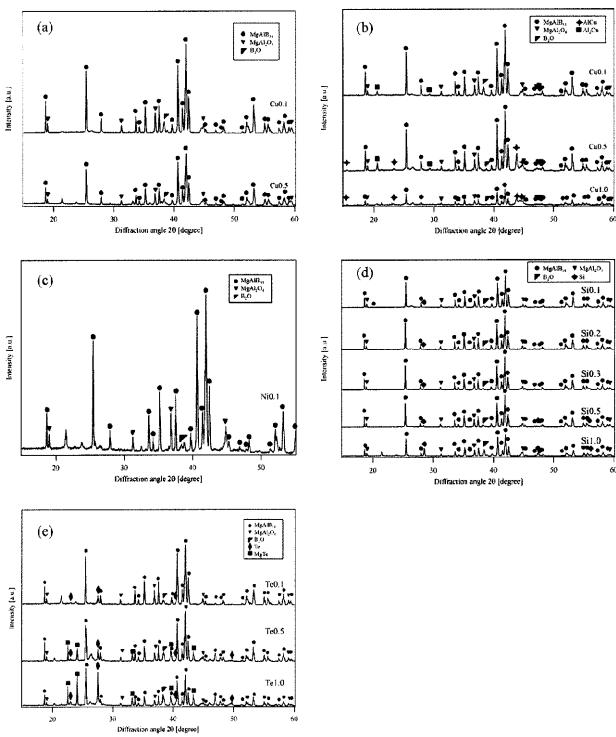
【図4】



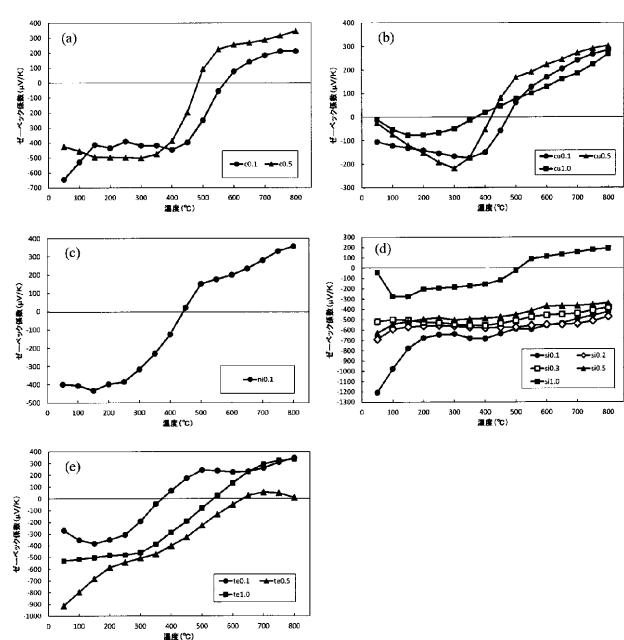
【図5】



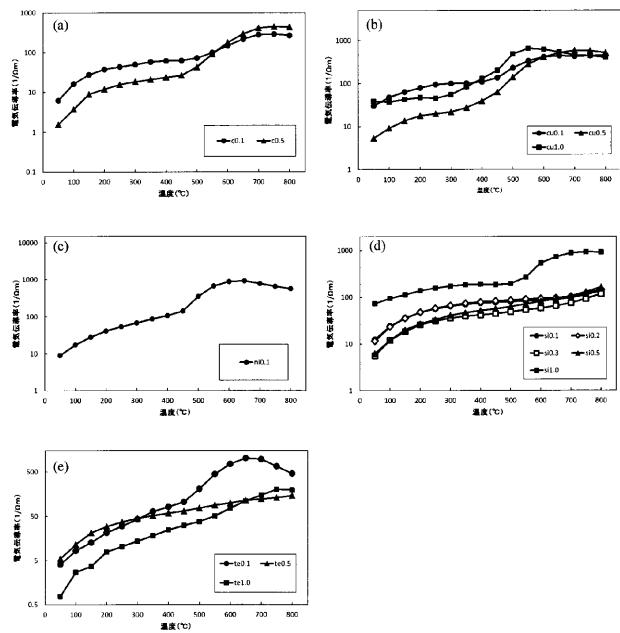
【図6】



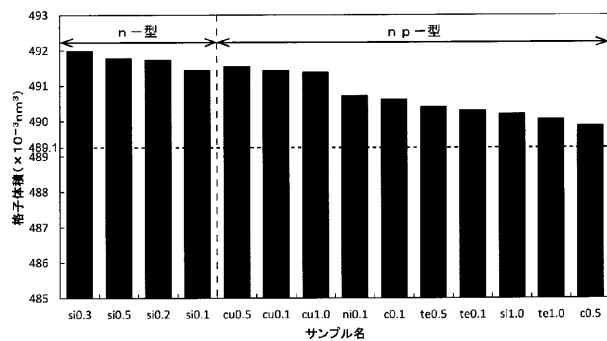
【図8】



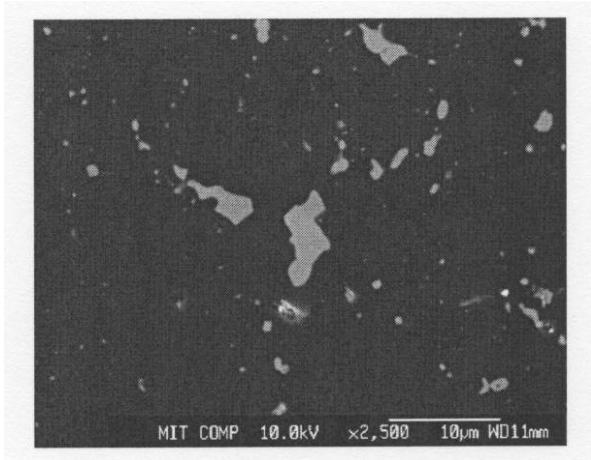
【図9】



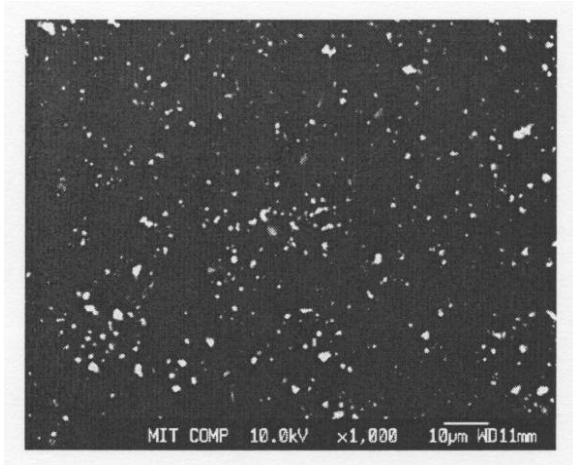
【図10】



【図2】



【図7】



MIT COMP 10.0kV ×1,000 10µm WD11mm

フロントページの続き

- (72)発明者 藤間 卓也
東京都世田谷区玉堤 1 - 2 8 - 1 東京都市大学内
- (72)発明者 佐々木 光
東京都世田谷区玉堤 1 - 2 8 - 1 東京都市大学内
- (72)発明者 高木 研一
東京都世田谷区玉堤 1 - 2 8 - 1 東京都市大学内